This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-10733

(43)公開日 平成10年(1998) 1月16日

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合

(51) Int.Cl.6	識別記	片 庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G03F 7	038 505		G 0 3 F	7/038	505	
7,	004 503			7/004	503	
7,	033			7/033		
HO1L 21	027		H01L	21/30	5021	R
			審査請求	え 未請求	請求項の数1	FD (全 9 頁)
(21)出願番号	特顯平8-178	670	(71)出願人		. •	
					戊ゴム株式会社	
(22)出顧日	平成8年(199	6)6月20日			中央区築地2丁目	目11番24号
			(72)発明者	計 岩永 体	中一郎	

成ゴム杉

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 はてん 体式 合社内

成ゴム株式会社内 (74)代理人 弁理士 福沢 俊明

成ゴム株式会社内

成ゴム株式会社内

(72)発明者 池崎 洋次

(72)発明者 大田 芳久

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ネガ型感放射線性樹脂組成物

(57) 【要約】

【目的】 高解像度で矩形のパターンを形成することができ、しかも感度、現像性、寸法忠実度等に優れた化学増幅型ネガ型レジストとして好適なネガ型感放射線性樹脂組成物を提供する。

【構成】 感放射線性樹脂組成物は、(イ) ヒドロキシスチレン単位の含有率が70~95モル%であるヒドロキシスチレン/(αーメチル)スチレン共重合体を含有するアルカリ可溶性樹脂、(ロ)感放射線性酸発生剤、

(ハ) 架橋剤を含有することを特徴とする。

【特許請求の範囲】

(イ) ヒドロキシスチレン単位の含有率 【請求項1】 が70~95モル%であるヒドロキシスチレン/スチレ ン共重合体およびヒドロキシスチレン/αーメチルスチ レン共重合体から選ばれる少なくとも1種の共重合体を 含有するアルカリ可溶性樹脂、(ロ)感放射線性酸発生 剤および(ハ)架橋剤を含有することを特徴とするネガ 型感放射線性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組 成物に関わり、さらに詳しくは、遠紫外線、X線あるい は荷電粒子線の如き放射線を用いる微細加工に好適な化 学増幅型ネガ型レジストとして有用なネガ型感放射線性 樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加 工の分野においては、より高い集積度を得るために、リ ソグラフィーにおける加工サイズの微細化が進んでお り、近年では、0.30μm以下の微細加工を安定的に 20 行なうことのできる技術が必要とされている。そのた め、用いられるレジストについても、0.30μm以下 のパターンを高精度に形成できることが求められてお り、その観点から、より波長の短い放射線を利用したリ ソグラフィーが検討されている。このような短波長の放 射線としては、KrFエキシマレーザー(波長248n m) およびArFエキシマレーザー (波長193nm) に代表される遠紫外線、シンクロトロン放射線に代表さ れるX線、電子線に代表される荷電粒子線等が用いられ ており、近年、これらの放射線に対応できる種々のレジ 30 ストが検討されている。そのようなレジストのうち特に 注目されているものに、放射線の照射(以下、「露光」 という。)によって生成する酸の触媒作用により、現像 液に対する溶解性を変化させる反応を起こすレジストが あり、この種のレジストは、通常、「化学増幅型レジス ト」と称されている。ところで、レジストを用いて実際 に集積回路を製造する際には、通常、感放射線性成分、 被膜形成性樹脂成分等のレジスト構成成分を溶剤に溶解 してレジスト溶液を調製し、該レジスト溶液を加工に供 される基板上に塗布して、レジスト被膜を形成させたの 40 ち、該レジスト被膜に、所定のマスクを介して露光し、 現像することにより、微細加工に適したパターンを形成 させるが、その際のパターン形状が微細加工の精度に重 大な影響を与え、矩形の形状が好ましいとされている。 従来の化学増幅型ネガ型レジストは、露光部で架橋反応 を進行させることにより、現像液への溶解速度を低下さ せて、パターンを形成させるが、当該レジストの現像液 に対する露光部と非露光部との間の溶解速度のコントラ ストが充分でないため、解像度が低く、またパターンの

らに露光部における現像液に対する溶解速度の低下も十 分でなく、パターンが現像液により膨潤したり、蛇行し たりする不都合もあった。一方、特公昭54-2357 4号公報には、感光性組成物の感放射線性酸発生剤とし て多くのハロゲン化有機化合物が有用であることが開示 されており、また特公平8-3635号公報には、トリ ス(2,3-ジブロモプロピル)イソシアヌレート等の ハロゲン含有化合物、ノボラック樹脂等のフェノール樹 脂および架橋剤からなる感光性組成物が開示されてい る。しかしながら、これらの感光性組成物は、KrFエ キシマレーザー (波長248 nm) に対する透明性が低 く、化学増幅型ネガ型レジストの特性として重要なパタ ーン形状、寸法忠実度等の面では満足できる水準にな い。また、特開平3-107162号公報および特開平 4-230757号公報には、アルコキシメチル化尿素 樹脂を架橋剤とするネガ型感光性組成物が開示されてい るが、このような架橋剤の選択だけでは、十分な解像度 を達成することが困難である。さらに近年、特に解像度 を改善した化学増幅型ネガ型レジスト組成物として、ア ルカリ可溶性樹脂の分散度を規定した組成物が、特開平 7-120924号公報、特開平7-311463号公 報、特開平8-44061号公報等に開示されている が、これらのレジスト組成物も、化学増幅型ネガ型レジ ストの特性として重要なパターン形状、寸法忠実度等の 面では未だ満足できない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、現像 時の現像残りがなく、高解像度で矩形のレジストパター ンを形成することができ、しかも感度、寸法忠実度等に 優れた化学増幅型ネガ型レジストとして好適なネガ型感 放射線性樹脂組成物を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明によると、前記課 題は、(イ)ヒドロキシスチレン単位の含有率が70~ 95モル%であるヒドロキシスチレン/スチレン共重合 体およびヒドロキシスチレン/αーメチルスチレン共重 合体から選ばれる少なくとも1種の共重合体を含有する アルカリ可溶性樹脂、(ロ) 感放射線性酸発生剤および (ハ) 架橋剤を含有することを特徴とするネガ型感放射 線性樹脂組成物、により解決される。

【0005】以下、本発明のネガ型感放射線性樹脂組成 物を構成する各成分について、順次説明する。

<u>(イ)アルカリ可溶性樹脂</u>

本発明におけるアルカリ可溶性樹脂は、ヒドロキシスチ レン単位の含有率が70~95モル%であり、好ましく は75~95モル%、さらに好ましくは80~95モル %であるヒドロキシスチレン/スチレン共重合体および /またはヒドロキシスチレン/αーメチルスチレン共重 合体(以下、これらの共重合体をまとめて「特定ヒドロ 頭部形状が矩形にならず丸くなるという欠点があり、さ 50 キシスチレン共重合体」という。)から選ばれる少なく

4

とも1種の共重合体を必須成分として含有する樹脂からなる。この場合、ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体およびヒドロキシスチレン/αーメチルスチレン共重合体中のヒドロキシスチレン単位の含有率が70モル%未満では、アルカリ現像液に対する溶解速度が低下し、レジストとしての現像性、解像度等が損なわれ、一方95モル%を超えると、パターン形状の劣化を来たす。また、特定ヒドロキシスチレン共重合体は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによるポリスチレン換算数平均分子量(以下、「Mw」という。)が3,000であり、かつMwとゲルパーミエーションクロマトグラフィーによるポリスチレン換算数平均分子量(以下、

「Mn」という。)との比(Mw/Mn)で定義される分散度が1.3以下、好ましくは1.25以下であることが望ましい。この場合、ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体およびヒドロキシスチレン/αーメチルスチレン共重合体のMwが3,000未満では、製膜性、レジストとしての感度等が低下する傾向があり、一方12,000を超えると、レジストとしての現像性、解像20度等が低下する傾向があり、また分散度が1.3を超えると、レジストとしての解像度等が低下する傾向がある。

【0006】特定ヒドロキシスチレン共重合体における ヒドロキシスチレンとしては、o-ヒドロキシスチレ ン、m-ヒドロキシスチレンあるいはp-ヒドロキシス チレンを挙げることができ、これらのヒドロキシスチレ ンは、単独でまたは2種以上を混合して使用することが できる。このような特定ヒドロキシスチレン共重合体の 具体例としては、o-ヒドロキシスチレン/スチレン共 30 重合体、οーヒドロキシスチレン/αーメチルスチレン 共重合体、m-ヒドロキシスチレン/スチレン共重合 体、mーヒドロキシスチレン/αーメチルスチレン共重 合体、p-ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体、p - ヒドロキシスチレン/α-メチルスチレン共重合体等 を挙げることができる。これらの共重合体のうち、特に p-ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体が好まし い。本発明において、特定ヒドロキシスチレン共重合体 は、単独でまたは2種以上を混合して使用することがで きる。特定ヒドロキシスチレン共重合体の製造法として は、例えば、(i)ヒドロキシスチレンの水酸基を保護 したモノマー、例えばブトキシカルボニルオキシスチレ ン、ブトキシスチレン、アセトキシスチレン、テトラヒ ドロピラニルオキシスチレン等を、スチレンおよび/ま たはαーメチルスチレンとともに、付加重合させたの ち、酸触媒を作用させることにより、該保護基を加水分 解して、特定ヒドロキシスチレン共重合体を得る方法、 (ii) ヒドロキシスチレンを、スチレンおよび/または

(11) ヒドロキシステレンを、ステレンおよび/または αーメチルスチレンとともに、付加重合させる方法等を 挙げることができるが、(i)の方法が好ましい。前記 50 付加重合は、例えばラジカル重合、アニオン重合、カチオン重合、熱重合等の適宜の方法により実施することができるが、アニオン重合またはカチオン重合による方法が、得られる共重合体の分散度を小さくできる点で好ましい。また、(i)の方法に使用される酸触媒としては、例えば、塩酸、硫酸等の無機酸を挙げることができる。

【0007】また、本発明におけるアルカリ可溶性樹脂 は、本発明の所期の効果を損なわない範囲で、特定ヒド ロキシスチレン共重合体以外に、ポリヒドロキシスチレ ン、ヒドロキシスチレンと他の不飽和モノマーとの共重 合体(但し、他の不飽和モノマーとは、ヒドロキシスチ レン、スチレンおよびαーメチルスチレン以外の不飽和 モノマーを意味する。)、ヒドロキシスチレンとスチレ ンおよび/または αーメチルスチレンと前記他の不飽和 モノマーとの共重合体や、これらの(共)重合体の水素 添加物のほか、ノボラック樹脂等を含有することもでき る。これらの(共)重合体、樹脂等は、単独でまたは2 種以上を混合して使用することができる。前記他の不飽 和モノマーとしては、例えば、ビニルトルエン、ビニル キシレン等の芳香族ビニル化合物; (メタ) アクリル酸 メチル、 (メタ) アクリル酸エチル、 (メタ) アクリル 酸n-プロピル、(メタ) アクリル酸 i - プロピル、

(メタ) アクリル酸 n ーブチル、 (メタ) アクリル酸 t ーブチル等の (メタ) アクリル酸アルキル類; クロトン酸メチル、けい皮酸メチル、マレイン酸ジメチル、フマル酸ジメチル等の (メタ) アクリル酸アルキル類以外の不飽和カルボン酸エステル類; (メタ) アクリロニトリル、シアン化ビニリデン、αークロロアクリロニトリル、シアン化ビニル化合物等を挙げることができる。これらの他の不飽和モノマーは、単独でまたは 2 種以上を混合して使用することができる。本発明におけるアルカリ可溶性樹脂中の特定ヒドロキシスチレン共重合体以外の (共) 重合体および樹脂の含有率は、通常、30重量%以下、好ましくは25重量%以下である。

【0008】 (口) 感放射線性酸発生剤

本発明における感放射線性酸発生剤(以下、「酸発生剤」と略記する。)としては、例えばハロゲン含有化合物、オニウム塩化合物、スルホン化合物、スルホン酸エステル化合物等を挙げることができるが、好ましくはハロゲン含有化合物である。ハロゲン含有化合物としては、特に、トリス(2、3ージブロモプロピル)イソシアヌレート、ペンタエリスリトールテトラブロマイド、2、2ービス(ブロモメチル)ー1、3ープロパンジオール、2ーブロモメチルー2ーヒドロキシメチルー1、3ープロパンジオール、トリブロモネオペンチルアルコール、テトラブロモビスフェノールAービス(ヒドロキシエチル)エーテルおよび1、4ービス(1、2ージブロモエチル)ベンゼンの群から選ばれる少なくとも1種の有機臭素化合物が最も好ましく、そのほか、フェニル

ービス (トリクロロメチル) - s - トリアジン等のトリ アジン誘導体等を挙げることができる。本発明におい て、ハロゲン含有化合物は、単独でまたは2種以上を混 合して使用することができ、またハロゲン含有化合物以 外の前記酸発生剤と組み合せて使用することもできる。 本発明における酸発生剤の配合量は、アルカリ可溶性樹 脂100重量部当たり、通常、0.01~20重量部、 好ましくは0.1~12重量部、さらに好ましくは2~ 10重量部である。この場合、酸発生剤の使用量が前記 範囲外であると、パターン形状が劣化する傾向がある。 【0009】 (ハ) 架橋剤

本発明における架橋剤は、酸、例えば露光により生じた 酸の存在下で、アルカリ可溶性樹脂を架橋しうる化合物 である。このような架橋剤としては、例えば、アルコキ シメチル化尿素樹脂、アルコキシメチル化メラミン樹 脂、アルコキシメチル化ウロン樹脂、アルコキシメチル 化グリコールウリル樹脂等のアルコキシメチル化アミノ 樹脂を挙げることができる。好適なアルコキシメチル化 アミノ樹脂の例としては、メトキシメチル化アミノ樹 脂、エトキシメチル化アミノ樹脂、n-プロポキシメチ ル化アミノ樹脂、nーブトキシメチル化アミノ樹脂等を 挙げることができ、好ましくはメトキシメチル化アミノ 樹脂であり、特に好ましくはメトキシメチル化尿素樹脂 である。本発明において、架橋剤として、メトキシメチ ル化尿素樹脂を使用することにより、解像度が特に優れ たネガ型感放射線性樹脂組成物を得ることができる。ま た、好適なアルコキシメチル化アミノ樹脂の市販品とし ては、PL-1170、PL-1174、UFR65、 CYMEL300、CYMEL303 (以上、三井サイ テック社製)、BX-4000、ニカラックMW-3 0、MX290 (以上、三和ケミカル社製) 等を挙げる ことができる。これらの架橋剤は、単独でまたは2種以 上を混合して使用することができる。本発明における架 橋剤の配合量は、アルカリ可溶性樹脂100重量部当た り、通常、3~60重量部、好ましくは5~40重量 部、さらに好ましくは5~30重量部である。この場 合、架橋剤の配合量が3重量部未満では、架橋反応を十 分進行させることが困難となり、レジストとして、残膜 率が低下したり、パターンの膨潤や蛇行を来たしやすく なり、また60重量部を超えると、レジストとしての解 40 像度が低下する傾向がある。

【0010】 <u>塩基性化合物</u>

本発明においては、露光により酸発生剤から生じた酸の レジスト被膜中における拡散現象を制御し、未露光領域 で好ましくない化学反応が起こるのを抑制する作用を有 する塩基性化合物を配合することが好ましい。このよう な塩基性化合物を使用することにより、レジストとして のパターン形状、マスクに対する寸法忠実度等を著しく 改善することができる。前記塩基性化合物としては、特 に窒素原子含有塩基性化合物が好ましく、具体的には、

例えば、2-フェニルピリジン、3-フェニルピリジ ン、4-フェニルピリジン、N-メチルアニリン、N. N-ジメチルアニリン、2-ベンジルピリジン、4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、ニコチン酸アミド、 トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリーnープロ ピルアミン、トリーn-ブチルアミン、トリーn-ヘキ シルアミン、トリーn-オクチルアミン、アクリジン等 を挙げることができる。これらの塩基性化合物のうち、 特に、4-フェニルピリジン、4,4'-ジアミノジフ ェニルメタン、トリーn-ブチルアミン、トリーn-オ クチルアミン、アクリジン等が好ましい。これらの塩基 性化合物は、単独でまたは2種以上を混合して使用する ことができる。塩基性化合物の配合量は、アルカリ可溶 性樹脂100重量部当たり、通常、0.001~10重 量部、好ましくは0.005~5重量部、さらに好まし くは0.01~3重量部である。この場合、塩基性化合 物の配合量が0.001重量部未満では、プロセス条件 によっては、レジストとしてのパターン形状、寸法忠実 度等が劣化する傾向があり、さらに、露光から露光後べ ークまでの引き置き時間 (Post Exposure Time Delay) が長くなると、パターン上層部においてパターン形状が 劣化する傾向がある。また塩基性化合物の配合量が10 重量部を超えると、レジストとしての感度、未露光部の 現像性等が低下する傾向がある。

【0011】添加剂

30

さらに、本発明のネガ型感放射線性樹脂組成物には、溶 解制御剤、溶解促進剤、増感剤、界面活性剤等の各種添 加剤を配合することができる。前記溶解制御剤は、アル カリ可溶性樹脂のアルカリ現像液に対する溶解性が高す ぎる場合に、その溶解性を制御し、アルカリ現像時のア ルカリ可溶性樹脂の溶解速度を適度に減少させる作用を 有する化合物である。このような溶解制御剤としては、 レジスト被膜の焼成、露光、現像等の工程において化学 変化しないものが好ましい。このような溶解制御剤とし ては、例えば、ナフタレン、フェナントレン、アントラ セン、アセナフテン等の芳香族炭化水素類;アセトフェ ノン、ベンゾフェノン、フェニルナフチルケトン等のケ トン類;メチルフェニルスルホン、ジフェニルスルホ ン、ジナフチルスルホン等のスルホン類等を挙げること ができる。これらの溶解制御剤は、単独でまたは2種以 上を混合して使用することができる。溶解制御剤の配合 量は、使用されるアルカリ可溶性樹脂の種類に応じて適 宜調節されるが、アルカリ可溶性樹脂100重量部当た り、通常、50重量部以下、好ましくは30重量部以下 である。前記溶解促進剤は、アルカリ可溶性樹脂のアル カリ現像液に対する溶解性が低すぎる場合に、その溶解 性を高めて、アルカリ現像時のアルカリ可溶性樹脂の溶 解速度を適度に増大させる作用を有する化合物である。 このような溶解促進剤としては、レジスト被膜の焼成、 露光、現像等の工程において化学変化しないものが好ま

しい。このような溶解促進剤としては、例えば、ベンゼ ン環数が2~6個程度の低分子量のフェノール性化合物 を挙げることができ、具体的には、例えば、ビスフェノ ール類、トリス(ヒドロキシフェニル)メタン等を挙げ ることができる。溶解促進剤の配合量は、使用されるア ルカリ可溶性樹脂の種類に応じて適宜調節されるが、ア ルカリ可溶性樹脂100重量部当たり、通常、50重量 部以下、好ましくは30重量部以下である。前記増感剤 は、露光された放射線のエネルギーを吸収して、そのエ ネルギーを酸発生剤に伝達し、それにより酸の生成量を 10 増加する作用を有し、レジストの見掛けの感度を向上さ せる化合物である。このような増感剤としては、例え ば、ベンゾフェノン類、ビアセチル類、ピレン類、フェ ノチアジン類、エオシン、ローズベンガラ等を挙げるこ とができる。 増感剤の配合量は、アルカリ可溶性樹脂1 00重量部当たり、通常、50重量部以下、好ましくは 30重量部以下である。前記界面活性剤は、本発明のネ ガ型感放射線性樹脂組成物の塗布性やストリエーショ ン、レジストとしての現像性等を改良する作用を有する 化合物である。このような界面活性剤としては、例え ば、商品名で、エフトップEF301、EF303、E F352 (以上、トーケムプロダクツ社製)、メガファ ックF171、F172、F173 (以上、大日本イン キ化学工業社製)、フロラードFC430、FC431 (以上、住友スリーエム社製)、サーフロンS-38 2, SC-101, SC-102, SC-103, SC-104、SC-105、SC-106(以上、旭硝子 社製)等のふっ素系界面活性剤を好ましいものとして挙 げることができる。界面活性剤の配合量は、アルカリ可 溶性樹脂100重量部当たり、界面活性剤の有効成分と して、通常、2重量部以下である。また、染料あるいは 顔料を配合することにより、露光部の潜像を可視化させ て、露光時のハレーションの影響を緩和でき、接着助剤 を配合することにより、基板との接着性を改善すること ができる。

【0012】溶剤

本発明のネガ型感放射線性樹脂組成物は、その使用に際 して、固形分濃度が、通常、5~50重量%となるよう に溶剤に溶解したのち、例えば孔径 0. 2 μ m程度のフ ィルターでろ過することによって、レジスト溶液として 40 調製される。前記レジスト溶液の調製に使用される溶剤 としては、例えば、エチレングリコールモノメチルエー テルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート、エチレングリコールモノプロピルエーテ ルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル アセテート等のエチレングリコールモノアルキルエーテ ルアセテート類;プロピレングリコールモノメチルエー テルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエー テルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエ

ーテルアセテート等のプロピレングリコールモノアルキ ルエーテルアセテート類;乳酸メチル、乳酸エチル、乳 酸プロピル、乳酸ブチル、乳酸アミル等の乳酸エステル 類;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチ ル、酢酸アミル、酢酸ヘキシル、プロピオン酸メチル、 プロピオン酸エチル等の脂肪族カルボン酸エステル類; 3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピ オン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、3-メトキシー2-メチ ルプロピオン酸メチル、3-メトキシブチルアセテー ト、3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-メトキシー3-メチルプロピオン酸ブチル、3-メトキ シー3-メチル酪酸ブチル、アセト酢酸メチル、ピルビ ン酸メチル、ピルビン酸エチル等の他のエステル類;ト ルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類;2-ヘプタノ ン、3-ヘプタノン、4-ヘプタノン、シクロヘキサノ ン等のケトン類;N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、 Ν-メチルピロリドン等のアミド類; γ-ラクトン等の ラクトン類等を挙げることができる。これらの溶剤は、 単独でまたは2種以上を混合して使用することができ る。

【0013】 レジストパターンの形成

本発明のネガ型感放射線性樹脂組成物からレジストパタ ーンを形成する際には、前記レジスト溶液を、回転塗 布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布手段によっ て、例えば、シリコンウエハー、アルミニウムで被覆さ れたウエハー等の基板上に塗布することにより、レジス ト被膜を形成したのち、所定のマスクパターンを介して 該レジスト被膜に露光する。その際に使用することので きる放射線としては、酸発生剤の種類に応じて、例え ば、i線等の紫外線、KrFエキシマレーザー (波長2 48 nm) およびArFエキシマレーザー (波長193 nm)等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、 電子線等の荷電粒子線の如き放射線を挙げることがで き、これらのうち遠紫外線が好適に使用される。本発明 においては、露光部における架橋反応をより効率的に進 行させるために、露光後に焼成(以下、「露光後ベー ク」という。)を行うことが好ましい。その加熱条件 は、組成物の配合組成、各添加剤の種類等により変わる が、通常、30~200℃、好ましくは50~150℃ である。次いで、アルカリ現像液で現像することによ り、所定のレジストパターンを形成する。前記アルカリ 現像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カ リウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、メタ珪酸ナ トリウム、アンモニア水、エチルアミン、nープロピル アミン、ジエチルアミン、ジーnープロピルアミン、ト リエチルアミン、メチルジエチルアミン、ジメチルエタ ノールアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルア ーテルアセテート、プロピレングリコールモノブチルエ 50 ンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒ

ドロキシド、コリン、ピロール、ピペリジン、1,8-ジアザビシクロー [5.4.0] - 7 - ウンデセン、 1, 5-ジアザビシクロー[4.3.0]-5-ノネン 等のアルカリ性化合物を、通常、1~10重量%、好ま しくは2~5重量%の濃度となるように溶解したアルカ リ性水溶液が使用される。また、前記アルカリ現像液に は、メタノール、エタノール等のアルコール類や界面活 性剤を適量添加することもできる。なお、このようなア ルカリ性水溶液からなる現像液を用いた場合は、一般 に、現像後、水で洗浄する。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、実施例を挙げて、本発明の 実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明 は、その要旨を超えない限り、これらの実施例に何ら制 約されるものではない。実施例および比較例中の各測定 および評価は、下記の方法により実施した。

Mwおよび分散度

東ソー(株)製高速GPC装置HLC-8020に、東 ソー (株) 製GPCカラム (G2000HxL:2本、G 3000HxL:1本、G4000HxL:1本) を用い、 測定試料を1重量%テトラヒドロフラン溶液とし、流量 1. 0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒドロフラ ン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレ ンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフ法 により測定した。

最適露光量(mJ/cm²)

得られたレジストパターンにおいて、線幅 0. 3μmの ライン・アンド・スペースパターン (1 L 1 S) を設計 通りに形成できる露光量を、最適露光量とした。

解像度 (μm)

最適露光量で露光したときに解像されている最小のレジ ストパターンの寸法を測定して、解像度とした。

現像性

シリコンウエハー上に形成した線幅 0. 3μmの1L1 Sの方形状断面を、走査型電子顕微鏡を用いて観察し、 下記基準で評価した。

〇: パターン間に現像残りが認められない。

△: パターン間に一部現像残りが認められる。

×: パターン間の現像残りが多い。

パターン形状

シリコンウエハー上に形成した線幅 0. 3μmの1L1 Sの方形状断面の下辺の寸法Laと上辺の寸法Lbと を、走査型電子顕微鏡を用いて測定して、

0. $8.5 \le L \, b / L \, a \le 1$

を満足し、かつパターン上層部が丸くないパターン形状 を"矩形"であるとして、下記基準で評価した。

(): パターン形状が矩形。

△: パターンの頭部が丸く、一部に膨潤が認められ る。

×: パターンが著しく膨潤し、蛇行しているか、また 50 ロー2:ペンタエリスリトールテトラブロマイド

10 はパターンが形成できない。

寸法忠実度

得られたレジストパターンにおいて、1L1Sのマスク 寸法を0.02μm間隔で小さくしながら、最適露光量 で露光したときのレジストパターン寸法とマスク寸法と の差を、走査型電子顕微鏡を用いて測定し、この差が土 10%以内であるときのマスクの最小設計寸法を、寸法 忠実度とした。

[0015]

10 【実施例】

実施例1~21および比較例1~3

表1~表4に示すアルカリ可溶性樹脂、酸発生剤、架橋 剤、塩基性化合物および溶剤を混合し、孔径 0. 2 μ m のフィルターで精密ろ過して異物を除去して、レジスト 溶液を調製した。得られた各レジスト溶液を、直径 4イ ンチのシリコンウエハー上に回転塗布したのち、120 ℃で焼成して、膜厚 0. 7 μ mのレジスト被膜を形成 し、該レジスト被膜にマスクパターンを介して、KェF エキシマレーザー (波長248μm) で露光したのち、 20 110℃で1分間露光後ベークを行った。次いで、2. 38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水 溶液を用い、パドル法により、23℃で60秒間現像を 行ったのち、水で30秒間洗浄し、乾燥して、ネガ型の レジストパターンを形成した。得られた各レジストパタ ーンの評価結果を、表1~表4に示す。

【0016】表中の各成分は、次のとおりである。

アルカリ可溶性樹脂

イ-1:p-ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体 (共重合モル比=85/15、Mw=3,800、分散度=1.15) 30 イ-2:p-ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体 (共重合モル比=90/10、Mw=6,000 、分散度=1.10) イ-3:p-ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体 (共重合モル比=75/25、Mw=9,000、分散度=1.20) A-4:p-ヒドロキシスチレン $/\alpha-$ メチルスチレン 共重合体(共重合モル比=80/20、Mw=10,000、分散 度=1.15)

イー5:m-ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体 (共重合モル比=75/25、Mw=5,000 、分散度=1.10) イー6:o-ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体 (共重合モル比=70/30、Mw=8,000 、分散度=1.20) 1 - 7: ポリ (p-ヒドロキシスチレン) (Mw=6,00 0 、分散度=1.10)

イー8:ポリ (p-ヒドロキシスチレン) (Mw=8,000 、分散度=3.30)

イー9:クレゾールノボラック樹脂(Mw=7,000、分 散度=2.10)

【0017】酸発生剤

ロー1:トリス(2,3-ジブロモプロピル)イソシア ヌレート

11

u-3:2, 2-ビス (ブロモメチル) -1, 3-プロパンジオール

ロー4:2-ブロモメチルー2-ヒドロキシメチルー

1, 3ープロパンジオール

ロー5:トリブロモネオペンチルアルコール

ロー6:テトラブロモビスフェノールA-ビス (2-ヒ

ドロキシメチル) エーテル

ロー7:1, 4ービス(1, 2ージブロモエチル)ベン

ゼン 架橋剤

ハ-1:メトキシメチル化尿素樹脂

ハー2:メトキシメチル化メラミン樹脂

ハ-3:メトキシメチル化グリコールウリル樹脂

* 塩基性化合物

ニー1:トリーn-ブチルアミン

ニー2:ニコチン酸アミド

ニー3:4,4'ージアミノジフェニルメタン

ニー4:アクリジン

溶剤

ホー1:乳酸エチル(2-ヒドロキシプロピオン酸エチ

12

ル)

ホー2:3-エトキシプロピオン酸エチル、

10 ホー3:2-ヘプタノン

[0018]

【表 1 】

表1

	<u> </u>							
				実	施	Øij		
		1	2	3	4	5	6	7
1	レカリ可溶性樹脂 重類 重量部	イー1 100	イー1 100	イー1 100	イー1 100	イー1 100	イー1 100	イ-1 100
1	论生剤 重類 重量部	□-1 6	□-2 6	□-3 7	□-4 7	□-5 8	□-6 7	□-7 6
1	語剤 重類 重 <u>用</u> 部	ハー 1 7	^−1 7	ハー1	^−1 7	ハー 1 6	ハー 1 8	^-1 8
1	性化合物 重類 重量部	=-1 0.3	=−1 0.3	=-1 0.3	=-2 0.2	=-2 0.2	=-1 0.2	=-2 0.2
	列 動類 反量部	ホー 1 425						
	最適露光量	45	50	45	52	50	40	50
-	(naJ/cm²) 解像度(μm)	0. 24	0. 24	0. 26	0. 26	0. 26	0. 26	0.26
評	現像性	0	0	0	0	0	0	0
価	パターン形状	0	0	0	0	0	0	0
	寸法忠実度 (μm)	0. 26	0. 26	0. 28	0. 28	0. 28	0. 28	0. 30

[0019]

【表2】

				実	旌	例		
		8	9	10	11	12	13	14
1	レカリ可溶性樹脂 重類 重量部	イー1 100	イー2 100	イー3 100	イー1 100	イー2 100	イー3 100	1-2 100
1	至生 利 重類 重量部	□-1 7	ם – 5 8	□-6 8	□-7 8	□-1 8	□-1 8	□-1 8
*	馬刺 重類 重量部	ハー1 8	^-1 9	ハー1 9	^-1 7	ハー 1 7	^-1 7	ハー1 8
*	性化合物 重類 重量部	=- 1 0.4	=− 1 0.4	=-1 0.5	=-2 0.4	=− 2 0.2	=-2 0.2	= −3 0.3
	列 重類 重量部	ホー2 425	ホー 3 425	ホー 3 425	ホー 1 425	ホー 1 425	ホー 1 425	ホー 1 425
	最適露光量	35	4 5	40	50	35	40	45
-	(mJ/cm²) 解像度(μm)	0. 24	0.26	0. 26	0.26	0. 28	0. 24	0. 22
評	現像性	0	0	0	0	0	0	0
価	パターン形状	0	0	0	0	0	0	0
	寸法忠実度 (μm)	0. 28	0. 28	0. 28	0. 28	0.30	0. 28	0. 26

[0020]

* *【表3】

表	3
	<u> </u>

				実	施	例		
		15	16	17	18	19	20	21
アルカリ可溶性協脂 種類 <u>重量</u> 部		イー4 100	イー5 100	イー 6 100	イー4 100	イー5 100	イー6 100	イー1 100
酸発生剤 種類 重量部		□ - 1 7	□-5 8	□ – 6 8	□-7 8	□-1 8	□-1 8	□-1 8
架橋剤 種類 重量部		^-1 8	ハー 1 9	ハー 1 9	^−1 7	^−1 7	^−1 7	^-1 8
塩基性化合物 種類 重量部		=-1 0.4	=-1 0.4	=-1 0.5	≃-2 0.4	<u></u>	=-2 0.2	=-3 0.3
	可 重類 重量部	ホー2 425	ホー 3 425	ホ-3 425	ホー 1 425	ホー 1 425	ホー 1 425	ホー 1 425
	最適露光量	40	45	45	50	40	35	45
Dent.	(mJ/cm²) 解 像 度(μm)	0. 26	0. 28	0. 26	0. 26	0. 28	0. 26	0. 24
評	現像性	0	0	0	0	0	0	0
価	パターン形状	0	0	0	0	0	0	0
	寸法忠実度 (μm)	0. 28	0. 30	0.30	0. 28	0. 30	0. 28	0. 28

16

15 <u>表 4</u>

		比 較 例					
		ı	2	3			
1	ルカリ可溶性樹脂 重類 重量部	イー7 100	イー8 100	イー9 100			
1	地生剂 重類 重量部	□-1 8	□-1 8	□-1 8			
1	香剤 重類 重量部	ハー 1 10	ハー 1 10	↑ 2 10			
1	基性化合物 重類 重量部	=−1 0.3	=− 1 0.3	=-1 0.3			
	列 重類 重量部	ホー 1 425	ホー 1 425	ホー 1 425			
	最適露光量 (mJ/cm²)	60	65				
評	解像度(µm)	0. 50	0. 50	_			
PT P	現像性	0	0	Δ			
価	パターン形状	Δ	Δ	×			
	寸法忠実度 (μm)	_	_	_			

* [0022]

【発明の効果】本発明のネガ型感放射線性樹脂組成物は、化学増幅型ネガ型レジストとして、高解像度で矩形のレジストパターンを形成することができ、かつ感度、現像性、寸法忠実度等にも優れており、しかもエキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如き遠紫外線以下の短波長放射線のいずれに対しても対応できるものであり、今後さらに微細化が進行するとみられる半導体デバイス製造10に極めて有用である。

20

フロントページの続き

(72)発明者 田辺 隆喜

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内